TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

TU Wien - Halbleiterphysik (362.129, 2023W, VU, 3.0h, 4.5ECTS)

Vorlesung: Prof. Alexander Grüneis & Prof. Benedikt Schwarz

Übungsgruppenleitung: Andreas Windischhofer & Johannes Fuchsberger

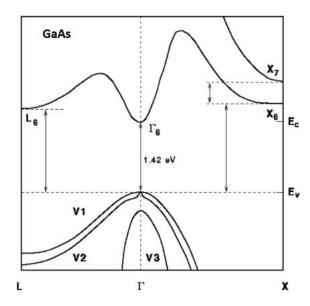
Übungsdatum: 18.12.2024



Übungsblatt 9

Beispiel 1: Interband-Absorption und LO-Phononen

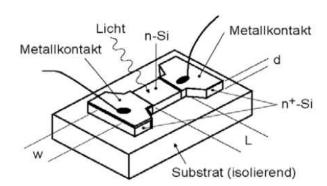
Galliumarsenid (GaAs) ist ein Halbleiter mit direktem Bandabstand. Die direkte Bandlücke bei Raumtemperatur beträgt $E_G = 1,42,\text{eV}$.



- a) Was passiert mit dem Elektron im Valenzband von GaAs, wenn der Halbleiter mit Laserlicht einer Wellenlänge von 775 nm beleuchtet wird?
- b) Skizzieren Sie den Weg der Elektronen direkt in die Bandstruktur aus der Abbildung.
- c) Während der energetischen Relaxation der Elektronen wird ihre Energie in Form von LO-Phononen abgegeben. Die Energie eines LO-Phonons in GaAs beträgt 36 meV. Wie viele LO-Phononen werden während dieses Prozesses erzeugt?

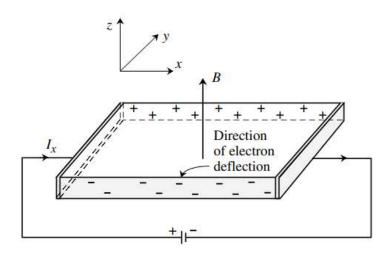
Beispiel 2: Photoleitungsdetektor

Die Abbildung zeigt die Struktur und Verdrahtung eines Silizium-Photoleitungsdetektors. Das Detektorelement besteht aus n-dotiertem Si $(N_D=5\cdot 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3})$. Die Abmessungen sind $w=L=100\,\mu\mathrm{m}$ und $d=1\,\mu\mathrm{m}$. Die Beweglichkeit der Elektronen beträgt $\mu_n=1500\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$, die Beweglichkeit der Löcher ist $\mu_p=500\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$. Der elektrische Widerstand der n⁺-Kontaktlagen und der Metallkontakte kann vernachlässigt werden.



- a) Was ist der elektrische Widerstand R des Detektors bei Raumtemperatur ($T=300\,\mathrm{K}$) ohne Beleuchtung?
- b) Das Detektorelement wird homogen mit Licht der Wellenlänge $\lambda = 800\,\mathrm{nm}$ beleuchtet. Die optische Leistung beträgt $0.1\,\mathrm{mW}$. Bei einer Quanteneffizienz von 20% beträgt die Generationsrate $G[\mathrm{s^{-1}cm^{-3}}]~8\cdot10^{21}\,\mathrm{s^{-1}cm^{-3}}$. Die Rekombinationszeit ist $\tau_{rec} = 10\,\mu\mathrm{s}$. Wie groß ist der elektrische Widerstand R des Detektors $(T = 300\,\mathrm{K})$ unter Beleuchtung?
- c) Wie sollte der Serienwiderstand R_V gewählt werden, damit die Spannungsschwankung $\Delta U = U_{(keinLicht)} U_{(mitLicht)}$ am Ausgang des Verstärkers $(V = 1, \text{ Eingangsresistanz} \rightarrow \infty)$ bei gegebener Beleuchtung maximiert wird?

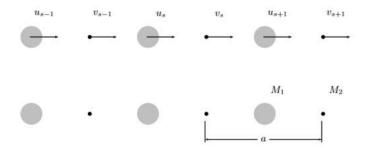
Beispiel 3: Stromtransport - Hall-Effekt



Eine Halbleiterprobe hat die Dimensionen $0.5\,\mathrm{cm}\times0.25\,\mathrm{cm}$ und ist $0.05\,\mathrm{cm}$ dick. Die Probe wird in einem Hall-Sonden-Setup gemessen. Bei einem angelegten elektrischen Feld von $1.0\,\mathrm{V/cm}$ fließt ein Strom von $20\,\mathrm{mA}$ (durch die lange Seite) in der Probe. Wenn ein $10\,\mathrm{kG}$ (1 T) Magnetfeld angelegt wird, wird eine Hall-Spannung von $10\,\mathrm{mV}$ gemessen. Wie groß sind die Hall-Mobilität und die Ladungsträgerdichte der Probe?

Beispiel 4: Diatomische Kette, Phonon-Dispersionsbeziehung (advanced)

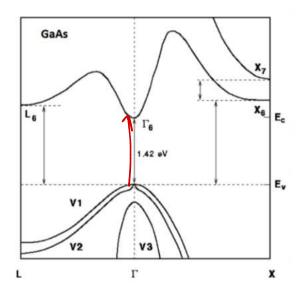
Betrachten Sie die normalen Moden einer linearen Kette, bei der die Federkonstanten zwischen benachbarten Atomen abwechselnd K und 10K sind. Die Massen seien gleich, und der Abstand zwischen benachbarten Atomen sei a/2.



- a) Leiten Sie die Dispersionsrelation $\omega(k)$ bei k=0 und $k=\pi/a$ her.
- b) Skizzieren Sie die Dispersionsrelation.
- c) Vergleichen Sie die in a) und b) berechnete Dispersionsrelation mit der Lösung für die Kette mit identischen Federn. Setzen Sie daher $K_1 = K_2$ und zeichnen Sie die Dispersionsrelation für identische Federn.

Beispiel 1: Interband-Absorption und LO-Phononen

Galliumarsenid (GaAs) ist ein Halbleiter mit direktem Bandabstand. Die direkte Bandlücke bei Raumtemperatur beträgt $E_G = 1,42,\text{eV}$.

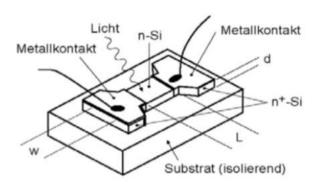


- a) Was passiert mit dem Elektron im Valenzband von GaAs, wenn der Halbleiter mit Laserlicht einer Wellenlänge von 775 nm beleuchtet wird?
- b) Skizzieren Sie den Weg der Elektronen direkt in die Bandstruktur aus der Abbildung.
- c) Während der energetischen Relaxation der Elektronen wird ihre Energie in Form von LO-Phononen abgegeben. Die Energie eines LO-Phonons in GaAs beträgt 36 meV. Wie viele LO-Phononen werden während dieses Prozesses erzeugt?

$$e = h = 7/6eV = Absorption$$

Beispiel 2: Photoleitungsdetektor

Die Abbildung zeigt die Struktur und Verdrahtung eines Silizium-Photoleitungsdetektors. Das Detektorelement besteht aus n-dotiertem Si $(N_D=5\cdot 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3})$. Die Abmessungen sind $w=L=100\,\mu\mathrm{m}$ und $d=1\,\mu\mathrm{m}$. Die Beweglichkeit der Elektronen beträgt $\mu_n=1500\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$, die Beweglichkeit der Löcher ist $\mu_p=500\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$. Der elektrische Widerstand der n⁺-Kontaktlagen und der Metallkontakte kann vernachlässigt werden.



- a) Was ist der elektrische Widerstand R des Detektors bei Raumtemperatur ($T=300\,\mathrm{K}$) ohne Beleuchtung?
- b) Das Detektorelement wird homogen mit Licht der Wellenlänge $\lambda = 800 \,\mathrm{nm}$ beleuchtet. Die optische Leistung beträgt $0.1 \,\mathrm{mW}$. Bei einer Quanteneffizienz von 20% beträgt die Generationsrate $G[\mathrm{s^{-1}cm^{-3}}] \, 8 \cdot 10^{21} \, \mathrm{s^{-1}cm^{-3}}$. Die Rekombinationszeit ist $\tau_{rec} = 10 \,\mu\mathrm{s}$. Wie groß ist der elektrische Widerstand R des Detektors $(T = 300 \,\mathrm{K})$ unter Beleuchtung?
- c) Wie sollte der Serienwiderstand R_V gewählt werden, damit die Spannungsschwankung $\Delta U = U_{(keinLicht)} U_{(mitLicht)}$ am Ausgang des Verstärkers $(V=1, \text{ Eingangsresistanz} \rightarrow \infty)$ bei gegebener Beleuchtung maximiert wird?

$$D_{\{n,p\}} = \frac{v_{\mathrm{T},\{n,p\}} \, \lambda_{\{n,p\},0}}{2}$$

$$\mu_{\{n,p\}}=\frac{qD_{\{n,p\}}}{k_{\mathbf{B}}T}$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = G - R \qquad \frac{\partial n}{\partial t} = G - R \qquad \frac{\partial cs}{\partial t} \quad \frac{\lambda cs}{\delta t} = \frac{\lambda cs}{\delta \frac{\lambda c$$

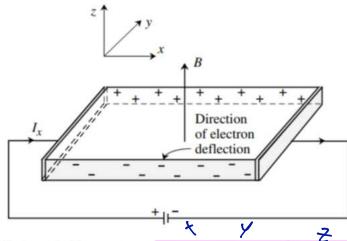
P... minoritaten

$$u = \frac{R}{R_{\nu} + R} u_{\nu}$$

c)

$$\frac{\Delta U = m \times 2}{V \times V} = \frac{\Delta U}{W} = \frac{\Delta$$

Beispiel 3: Stromtransport - Hall-Effekt



Eine Halbleiterprobe hat die Dimensionen $0.5\,\mathrm{cm}\times0.25\,\mathrm{cm}$ und ist $0.05\,\mathrm{cm}$ dick. Die Probe wird in einem Hall-Sonden-Setup gemessen. Bei einem angelegten elektrischen Feld von $1.0\,\mathrm{V/cm}$ fließt ein Strom von $20\,\mathrm{mA}$ (durch die lange Seite) in der Probe. Wenn ein $10\,\mathrm{kG}$ (1 T) Magnetfeld angelegt wird, wird eine Hall-Spannung von $10\,\mathrm{mV}$ gemessen. Wie groß sind die Hall-Mobilität und die Ladungsträgerdichte der Probe?

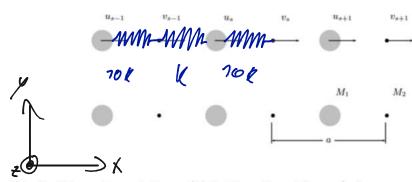
$$U_H = -\mu E_x BY$$

$$\frac{\mathcal{L}}{\mathcal{H} A} = \frac{12m^{2} \mathcal{L}}{20mA}$$

$$P = \frac{70 \text{ mA}}{1 \text{ cm}} \cdot 0,25 \cdot 0,05 \text{ cm}^{2} = 16 \text{ m}$$

Beispiel 4: Diatomische Kette, Phonon-Dispersionsbeziehung (advanced)

Betrachten Sie die normalen Moden einer linearen Kette, bei der die Federkonstanten zwischen benachbarten Atomen abwechselnd K und 10K sind. Die Massen seien gleich, und der Abstand zwischen benachbarten Atomen sei a/2.



- a) Leiten Sie die Dispersions
relation $\omega(k)$ bei k=0 und $k=\pi/a$ her.
- b) Skizzieren Sie die Dispersionsrelation.
- c) Vergleichen Sie die in a) und b) berechnete Dispersionsrelation mit der Lösung für die Kette mit identischen Federn. Setzen Sie daher $K_1 = K_2$ und zeichnen Sie die Dispersionsrelation für identische Federn.

Foder: Kvaft ist proportional zar Auslankung:

$$F = -70 \left(U_s - V_s \right) - k \left(U_s - V_{s-1} \right)$$

$$M_1 \frac{d^2 u_s}{d + 2} = -70k(u_s - v_s) - k(u_s - v_{s-1})$$

$$V_S = A_2 e^{-\frac{1}{2}(qdn-w+)}$$

The signal and the s

 $(M_{1} - 11 R)(M_{2} - 11 R) - R(10 + e^{iq q})(10 + e^{iq q}) = 0$ $(M_{1} - 11 R)(M_{2} - 11 R) - R(10 + 10 + e^{iq q})(100 + 10 + e^{iq q}) = 0$ $(M_{1} - 11 R)(M_{2} - M_{2} - 11 R)(M_{1} + M_{2}) + (11 R)^{2} - R(100 + 10 + e^{iq q})(100 + 10 + e^{iq q}) = 0$ $w'(M_{1} - 11 R)(M_{1} + M_{2}) + (11 R)^{2} - R(100 + 10 + e^{iq q})(100 + 10 + e^{iq q}) = 0$

W:= W2

$$= \frac{11k(M_1+M_2)}{2M_1M_2} \left(7 \pm \sqrt{\frac{(M_1-M_2)^2}{(M_1+M_2)^2}} \pm \frac{1}{k} (101+20\cos(94)) + \frac{1}{4} (1$$

$$= \frac{11k(N_1+N_2)}{2N_1N_2} \left(1 + \sqrt{\frac{(N_1-N_2)^2}{(N_1+N_2)^2}} + \frac{(121+10\sin^2(\frac{99}{2}))4N_1N_2}{121(N_1+N_2)^2} \right)$$

$$= \frac{11k(M_1+N_2)}{2M_1M_2} \left(1 \pm \sqrt{\frac{M_1^2 + 2M_1M_2 + \frac{10}{12N_1} + \frac{10}{12N_1} + \frac{10}{12N_1} + \frac{10}{2N_1} + \frac{10}{2N_1}$$

$$W(q) = \sqrt{\frac{11k(M_1 + N_2)}{2M_1M_2}} \left(1 + \frac{1}{1 + 1} + \frac{M_1M_2}{(N_1 + M_2)^2} + \frac{10}{727} \sin^2(\frac{qq}{2})^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

